

3DG512C 型 NPN 硅高频小功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值	单位
极 限 值	P_{CM}	$T_A=25^{\circ}C$	1	W
	I_{CM}		2	A
	T_{jm}		175	$^{\circ}C$
直 流 参 数	$V_{(BR)CBO}$	$I_{CB}=0.1mA$	≥ 140	V
	$V_{(BR)CEO}$	$I_{CE}=0.1mA$	≥ 140	V
	I_{CBO}	$V_{CB}=30V$	≤ 1.0	μA
	I_{CEO}	$V_{CE}=30V$	≤ 1.0	μA
	V_{BEsat}	$I_C=500mA$	≤ 0.5	V
	V_{CEsat}	$I_B=50mA$	≤ 1.3	
	h_{FE}	$V_{CE}=2V$ $I_C=500mA$	≥ 50	
外 引 线 说 明	 1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极 A3-02B(B4)			
替代型号：				